

Development of 14 Gbit/s Uncooled TOSA with a Wide Operating Temperature Range — by Shunsuke Sato, Hayato Fujita, Keiji Tanaka, Akihito Moto, Masaaki Ono and Tomoya Saeki — The authors have successfully developed new TOSAs (Transmitter Optical Sub-Assembly) which are operational for a wide operating temperature range from -40 to 90 degree C and high speed of 10 Gbit/s or more. The device introduced multi-layer ceramic packages with a precisely controlled characteristic impedance and wide frequency characteristics up to 23 GHz. In addition, an optical system using front facet monitoring technique has achieved stable tracking error characteristics within ±0.2 dB. A newly designed laser driver IC is also mounted in a package to ensure both high speed performance for 16GFC and low power consumption for high density aggregation of transmission systems.

Keywords: ceramics package, uncooled TOSA, XMD-MSA, 10GBASE-LR, 16GFC

1. 緒 言

近年の情報通信トラフィックの増加に伴い、伝送装置の 大容量化、高速化への要求が高まっている。装置に搭載さ れる光トランシーバは、現在XFP(10Gbit/s Small Form Factor Pluggable)や SFP+(Small Form Factor Pluggable Plus)⁽¹⁾と呼ばれる小型の製品が主流となって おり、その伝送速度は10Gbit/sに達する。伝送装置の大 容量化の実現には、スイッチやルータなどの伝送装置に搭 載する光トランシーバ数を増加させる必要がある。光トラ ンシーバ数の増加に伴い発熱量が増加するため、より高い 温度での動作が要求される。伝送速度の高速化に対する要 求も高まっており、10Gbit/s以上の伝送速度に対応する光 デバイスの開発が望まれる。また、伝送装置の低消費電力 化に対する要求も強く、SFP+では最大消費電力が1W以 下に仕様化され、低消費電力で駆動可能なTOSA (Transmitter Optical Sub-Assembly)が必要とされる。

今回、XFPやSFP+に搭載可能で、伝送距離10km以下 を対象とし、DML (Direct Modulated Laser diode)を 搭載した無温調型TOSAを開発した。本稿では、高速動作 を可能とする新規パッケージを採用したTOSAの構造、低 消費電力を実現するTOSA回路構成について報告する。

2. TOSA の基本構造

TOSAの主要諸元を表1に示す。

TOSAの構造は、XMD-MSA (10Gbit/s Miniature Device Multi Source Agreement) に準拠しており、電 気・光学特性は10ギガビット・イーサーネット (以下、 10GBASE-LR) および16ギガファイバーチャネル (以下、 16GFC) に準拠する。伝送距離は10km以下であり、伝送 速度は10GBASE-LRが10.3125Gbit/s、16GFCが 14.025Gbit/sとなる。光インターフェースはLCレセプタ クルで、電気インターフェースは8ピンのフレキシブル基 板となる。

表1 TOSA の主要諸元

用途	10GBASE-LR	16GFC	
規格	IEEE802.3ae	FC-PI-5	
外形寸法	XMD-MSA 準拠		
光インターフェース	LC レセプタクル		
電気インターフェース	8ピンフレキシブル基板		
動作温度	-40∼90 °C	-5∼90 °C	
伝送速度	10.3125Gbit/s	14.025Gbit/s	
伝送距離	10km Max.	10km Max.	
中心波長	1260~1355nm	1295~1325nm	
光出力パワー	-8.2dBm Min.	-4.9dBm Min.	
RIN12OMA	-128dB/Hz Max.	-130dB/Hz Max.	
消光比	3.5dB Min.	3.5dB Min.	
トラッキングエラー	± 1.0dB	± 1.0dB	
駆動方式	直接変調	駆動IC内蔵	
消費電力	120mW Max.	300mW Max.	

一般的なTOSAを構成するパッケージは、温調型TOSA では箱型パッケージ、無温調型TOSAでは同軸型パッケー ジが採用される。箱型パッケージは伝送線路を構成するセ ラミックス部と筐体外形を構成する金属部からなる。伝送 線路の設計最適化により、良好な高周波特性の実現が可能 であるが、複数の構成部品からなる構造が複雑であり高価 となる。一方、同軸型パッケージは円盤形状の金属部にガ ラス封止されたリード端子が搭載され、安価に製造可能で あるが、伝送線路の形成が難しく10GHzを超える高周波 特性の実現が困難であった。

そこで今回、16GFCに対応すべく10GHz以上の高周波 特性を有し、構造が単純で安価に製造できる新規のパッ ケージを採用した無温調型TOSAを開発した。図1に従来 構造(同軸型パッケージ)と新規構造のTOSAの外観を示 す。新規構造では水晶発振子などに用いられる積層セラ ミックスのパッケージをベースとして、伝送線路の設計最 適化により10GHz以上の高周波特性を実現した。端面発 光型レーザダイオード(以下、LD)、その光を垂直方向に 屈曲するためプリズム、光出力をモニタするフォトダイ オード(以下、PD)、ヒートシンクを□5.4mmのパッ ケージ内部に搭載した。半導体部品を保護すべく、気密封 止に用いるリッドに搭載した球レンズにより、集光して光 ファイバに光結合する。

TOSAの回路構成は、①LDを差動の変調信号で駆動さ せる方式、②TOSA内部に駆動ICを搭載してLDを駆動さ せる方式の2種類を採用し、それぞれに対応したパッケー ジを開発した。TOSAの伝送線路の特性インピーダンスは、 ①では差動信号間50Ω、②では差動信号間100Ωとして 設計した。



図1 無温調型TOSAの外観



図2 光学系概念図

を実装する。LDの前方出力は光軸方向と一致しており、 レンズで集光されて光ファイバに結合される。一方、新規 構造では、光軸方向に垂直な同一平面上にLD、ヒートシ ンク、プリズム、PDを実装する。LDの前方出力はプリズ ムで屈曲して光軸方向に出射され、レンズで集光されて光 ファイバに結合される。

3-1 光出力モニタ方式 従来構造の光学系では、 LDの前方出力を球レンズで集光して光ファイバに結合し、 後方出力をPDで受けて光出力のモニタを行う。LDから出 射される光出力の前後比は温度によって変動してしまい、 PDで受けるモニタ電流値が一定となるようにLDの電流を 制御しても、光ファイバで受ける光出力は±1.0dB 程度の ばらつきが生じる。

一方、新規構造の光学系では、LDの前方出力をプリズ ムで屈曲させて球レンズで集光して光ファイバに結合す る。プリズムの斜面には反射膜が施されており、光出力の 一部がプリズムを透過してPDで受けて光出力のモニタを



3. 光学設計

図2に光学系の概念図を示す。従来構造のTOSAで使用 される光学系では、TOSAの光軸方向に対して垂直方向に LDとヒートシンクを実装し、光軸方向に角度を付けてPD 行う。LDの前方出力をプリズムで分岐し、その一部をPD で受ける設計であり、安定した出力の管理が可能となる。

図3は新規の光学系におけるトラッキングエラー特性を 評価した結果を示す。-40~90℃の広い温度範囲において、 光出力のばらつきは±0.2dB以内と良好な結果が得られた。

3-2 反射戻り光抑制方式 LDに外部からの反射光 が入射すると、相対強度雑音 (RIN: Relative Intensity Noise)が劣化してしまい、信号品質に影響を及ぼすため、 TOSAの外部で生じた反射戻り光の抑制が必要となる。一 般的には、逆方向の光を抑制する素子であるアイソレータ を搭載して、反射戻り光を抑制する構造を採用するが、 TOSA製品のコスト増につながる。

高価なアイソレータを搭載することなく反射戻り光を抑 制する構造として、プリズムの反射膜に着目した光学系を 実現した。本開発の無温調型TOSAで用いるLDは通常の 駆動条件において光出力が1dBm 程度あり、TOSAの要求 光出力に対して十分強い光出力を有している。一般に、LD の光出力からレンズの結合効率を乗算した値に対して、 TOSAの要求光出力が小さい場合は、最適調芯点より光 ファイバを遠ざけるデフォーカスよりに光出力を小さくす る。しかし本開発では、TOSAの要求光出力が得られる程 度にプリズムの反射率を低く設計した。プリズムを透過し た光は、プリズムの前方に配置する PD に入射し、光出力 強度に応じたモニタ電流が出力される。

一方、TOSA外部からの反射戻り光に対して、光ファイ バを伝搬してきた光はレンズによりLDに集光される。そ の際、本設計では光路上にプリズムが配置されており、そ の反射膜の反射率により、大部分の光はプリズムを透過し て、LDに結合されない。これにより外部で生じた反射戻 り光を抑制する構造を実現した。

図4はTOSAに-12dBの反射戻り光を加えた際の RIN₁₂OMA特性を示す。-128dB/Hz以下の要求仕様に対 して、-130dB/Hz以下の特性が得られており、反射戻り 光を抑制する構造が機能している結果が得られた。



図4 RIN12OMA 特性

4. 高周波設計

TOSAの伝送線路の特性インピーダンスを差動50Ωで 設計したパッケージについて、従来の同軸構造との高周波 特性比較を実施した。下記にその詳細を示す。

4-1 周波数特性 従来構造のパッケージでは、高 周波信号は①フレキシブル基板以下 (FPC) の伝送線路、 ②ガラス封止されたリードピン、③パッケージ内部に実装 されたヒートシンク基板上の伝送線路、を介してLDに伝 わる。各部における伝送線路の特性インピーダンスを整合 する設計は可能であるが、①と②および②と③の接続部に おける特性インピーダンスを整合することが難しく、 10Gbit/sを超えた伝送速度の実現が容易ではなかった。一 方、新規構造のパッケージでは、④FPCの伝送線路、⑤ パッケージ内部の伝送線路、⑥パッケージ内部に実装され たヒートシンク基板上の伝送線路からなる。新規構造では、 セラミックス上に設けた伝送線路幅の調整が容易であり、 各部の特性インピーダンスを整合させる設計自由度が高 く、接続部で生じる特性インピーダンスの不整合を補正す ることができる。これにより優れた高周波特性を実現する ことが可能となる。

従来構造と新規構造のパッケージに対して、電磁界解析 を用いたパッケージの周波数特性解析を行った。解析に用 いたモデルを図5に示す。FPC、パッケージ、ヒートシン ク、キャップまたはリッドからなり、FPCの伝送線路に設 けた Port1 から、ヒートシンク上の伝送線路の対称面に設 けたPort2における周波数特性を解析した。



図6に従来構造と新規構造における透過の周波数(S21) 特性の解析結果を示す。従来構造のパッケージでは、特性 インピーダンスの不整合部分で生じる反射が影響してお り、帯域は9GHz程度となる。一方、新規構造のパッケー



図6 パッケージの周波数特性

ジでは、特性インピーダンスの整合最適化により、23GHz 以上の帯域を確保している。

4-2 特性インピーダンス特性 図7にTOSAの TDR (Time Domain Reflectometry) 測定による特性イ ンピーダンスの測定結果を示す。測定サンプルは、FPC、 パッケージ、ヒートシンク、LDを搭載しており、FPC端 からの特性インピーダンスを示す。TOSAの伝送線路は差 動入力信号間で特性インピーダンスが50Ωとなるように 設計している。



図7 差動特性インピーダンス

図7のグラフで横軸は時間で信号がその時間で到達する部 位を示しており、①0~50psの部分はFPCを回路基板と接 続するパッド部、②50~150psはFPCの伝送線路、③150 ~200psはパッケージ部、④200ps以降はLDに対応し、縦 軸は特性インピーダンスを示す。

従来構造では150ps以降のパッケージ部の特性インピー ダンス不整合が顕著であり、最大59Ω程度であるのに対 して、新規構造では特性インピーダンスの制御が可能で、 ②以降の特性インピーダンス変動幅は3Ω以下と非常に良 好な特性インピーダンス整合を実現している。

5. 低消費電力設計

SFP+などの光トランシーバの消費電力を削減する TOSA駆動方式として、当社ではTOSA内蔵型シャント駆 動ICの開発^{(2)~(4)}を行ってきた。

シャント駆動とは、図8に示すようにLDと並列接続さ れたトランジスタをスイッチし、LDに流れる電流を変調 する方式である。TOSA内部に電圧電流変換利得を持つト ランジスタを設置することでTOSA外部から供給する変調 電流を小さくできる利点がある。SFP+では最大消費電力 を1W以下に設計する必要があり、TOSAの消費電力は 300mW以下を目標に設計を行った。



図8 シャント駆動方式の送信回路構成

今回、高周波特性を実現する新規パッケージに搭載可能 で16GFC動作に対応した新たなTOSA内蔵型LD駆動IC の開発を行った。回路方式として、シャント方式よりも高 速動作に適したプッシュプル駆動方式を採用した。プッ シュプル駆動方式とはLDと並列および直列に接続した2 石のトランジスタを交互にスイッチし、並列に接続された トランジスタは電流を吸い込み(プル)、直列に接続され たトランジスタは電流を吐き出す(プッシュ)ことで、LD に流れる電流を変調する。プッシュプル方式はシャント方 式と比べ1石あたりの負荷電流を小さくできるため、高速 動作に適している。

図9にプッシュプル駆動方式の送信回路構成を示す。 プッシュプル駆動方式の送信回路はプッシュプル駆動ICと それを駆動するVCSELドライバから構成される。



図9 プッシュプル駆動方式の送信回路構成

プッシュプル駆動ICはTOSA外部のVCSELドライバIC から差動特性インピーダンス100Ωの伝送線路を介して差 動電圧信号で駆動される。プッシュプル駆動ICは差動終端 抵抗R1を内蔵しており、特性インピーダンスと整合するよ うに100Ωに調整している。バッファ回路(AMP)は、電 圧制御電流源II,I2の入力負荷を入力から分離する為に挿 入してある。入力された差動電圧信号はバッファ回路を介 して電圧制御電流源を交互にスイッチする。LDにはTOSA 外部の電流源から直流電流が供給される。直流電流供給用 の線路から高周波電流の漏れが発生しないようにチョーク コイルL1がLDアノード端子側に接続されている。

6. 光出力波形

6-1 10GBASE-LR特性評価 今回開発した無温調型 TOSAの波形評価を10GBASE-LRに対応した駆動条件に て行った。図10に光出力波形を示す。伝送速度は 10.3125Gbit/s、消光比5.0dB、TOSAのケース温度 Tc=-40~90[°]Cの範囲における光波形の温度特性を示す。 25[°]Cおよび-40[°]Cではパルスマスクマージンは50%以上、 90[°]Cの高温環境下でも30%以上を確保しており、良好な アイ開口が得られた。



図10 10GBASE-LRの光波形温度特性

6-2 16GFC特性評価 今回開発した駆動IC内蔵 TOSAにおける電気光変換特性を**図11**に示す。高周波帯域 は14GHz程度あり、14Gbit/s動作に必要な帯域を確保し ている。

同様に、TOSAを16GFCに対応した駆動条件にて波形評 価を行った。図12に光出力波形を示す。伝送速度は 14.025Gbit/s、消光比5.0dB、TOSAのケース温度Tc=-10 ~90℃の範囲における光波形の温度特性を示す。全温度 においてパルスマスクマージンは30%以上確保しており、



図11 電気光変換特性



図12 16GFCの光波形温度特性



図13 TOSAの消費電力温度特性

良好なアイ開口が得られている。図13にTOSAの消費電 力温度特性を示す。高温環境においても目標仕様を満足し ている。

7. 結 言

10GBASE-LRおよび16GFC用途に使用する無温調型 TOSAを開発した。90℃の高温環境で動作可能で、 14Gbit/sにて十分なマスクマージンを確保できることを確 認した。また、新たな駆動ICを内蔵することで光トラン シーバの低消費電力化を実現でき、当社顧客における伝送 装置の低消費電力化に十分貢献できる。

用語集

XFP

10 Gigabit Small Form Factor Pluggable : 活栓挿抜可 能な10Gbit/s 対応光トランシーバ

SFP+

Small Form Factor Pluggable Plus:活栓挿抜可能な小型の10Gbit/s対応光トランシーバ

TOSA

Transmitter Optical Sub-Assembly : 送信用小型光デバ イス

DML

Direct Modulated Laser diode:直接変調型半導体レーザ、変調電流を半導体レーザに直接入力し光信号を得る

XMD-MSA

10Gbit/s Miniature Device Multi Source Agreement: 光モジュールサプライヤ各社が、製品仕様を共通化し、市 場拡大を図るための取り決め

トラッキングエラー特性

PDの電流値を一定となるよう LD 電流を制御した際の光 ファイバで得られる光パワーの変動幅

TDR

Time Domain Reflectometry:時間領域反射、伝送線路 に高速なパルス信号を印加し、反射波形を観測することで、 特性インピーダンスの変化点を測定する手法

参考文献

- SFF Committee, SFF-8431 Specifications for Enhanced 8.5G and 10Gigabit Small Form Factor Pluggable Module, "SFP+", Rev 2.2, December (2007)
- (2)本他、「10Gb/s動作可能な低消費電力DFB-LD駆動ICの開発」、電子 情報通信学会総合大会、C-12-36、March (2009)
- (3) 佐藤 他、「低消費電力駆動可能なSFP+用シャント駆動TOSA」、電子 情報通信学会 総合大会、C-3-14、March (2009)
- (4) 田中他、「SFP+用低消費電力ICチップセットの開発」、SEIテクニカ ルレビュー第175号、p114-119、July (2009)

執 筆 者------





藤田 勇人*: 伝送デバイス研究所 部品実装研究部 光送信デバイス・ICの開発に従事



田中	啓二	:伝送デバイス研究所	回路技術研究部	グループ長
本	昭宏	:伝送デバイス研究所	回路技術研究部	
小野	雅章	:伝送デバイス研究所	部品実装研究部	グループ長
佐伯	智哉	:住友電エデバイス・1	イノベーション(株)	光デバイス開発部

* 主執筆者